

WH-GM5-mPCIe 硬件设计手册

文件版本：V1.0.0



目录

WH-GM5-mPCIe 硬件设计手册	1
1. 关于文档	3
1.1. 文档目的	3
1.2. 产品外观	3
1.3. 参考文档列表	4
2. 产品简介	5
2.1. 产品特点	5
2.2. 基本参数	5
2.3. 模块框图	7
2.4. 外形尺寸	7
2.4.1. 模块尺寸	7
2.4.2. Mini-PCIe	9
2.4.3. IPEX	10
2.5. 引脚定义	11
3. 硬件参考设计	14
3.1. 电源接口	14
3.2. USB 接口	15
3.3. UART 接口	16
3.4. SIM 卡接口	17
4. 电气特性	19
4.1. 工作存储温度	19
4.2. 输入电源	19
4.3. 模块 IO 口电平	19
5. 联系方式	20
6. 免责声明	21
7. 更新历史	22

1. 关于文档

1.1. 文档目的

本文详细阐述了 WH-GM5-mPCIe 无线模块的基本功能和主要特点、硬件接口及使用方法、结构特性等电气指标。通过阅读本文档，用户可以对本产品有整体认识，对产品规格参数有明确了解，顺利将模块嵌入各种终端设计中。

1.2. 产品外观

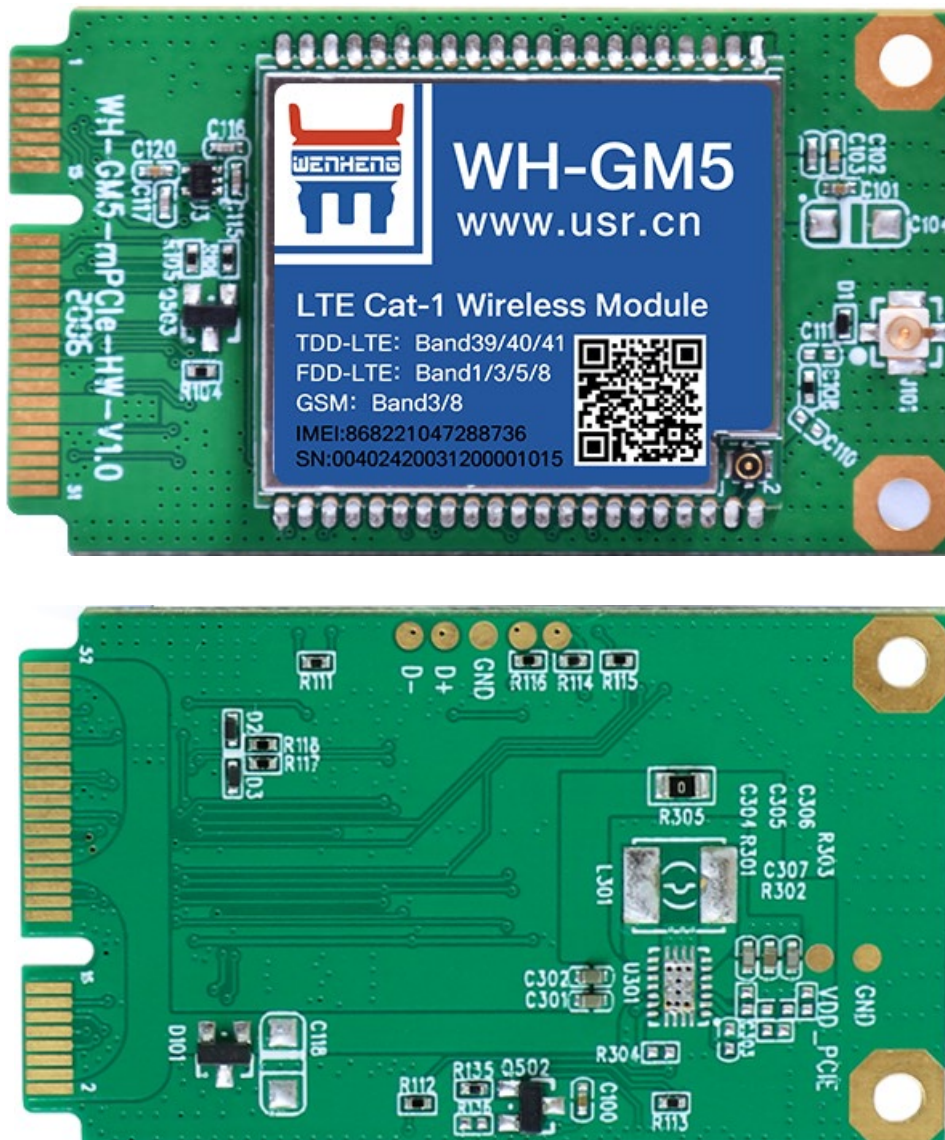


图 1 Product appearance

1.3. 参考文档列表

除此硬件开发文档外，我们同时提供了基于本产品的说明书、封装库等资料，方便用户设计参考。

表 1 Support Document List

文档标号	文档名称
1	WH-GM5 说明书
2	WH-GM5 AT 命令手册
3	WH-GM5 Linux 系统 PC 侧驱动编译与安装说明

2. 产品简介

WH-GM5-mPCIe 是一款适用于 LTE Cat1 蜂窝网络的无线终端产品，支持所有移动网络的高速接入，能够为用户提供高速的无线数据、互联网接入等业务，具备语音、分组数据、短信功能、通讯簿，可以快速轻松帮助你实现嵌入式模块、移动电话、智能手机、多媒体手机和触摸屏通信装置、调制解调器、U 猫、车载设备等终端。

WH-GM5-mPCIe 采用先进的高度集成设计方案，将射频、基带集成在一块 PCI express Mini Card 全卡尺寸的 PCB 上，完成无线接收、发射、基带信号处理和音频信号处理功能。支持 AT 命令扩展，可以实现用户个性化定制方案。

2.1. 产品特点

- 支持移动 2G/LTE Cat-1
- 支持联通 2G/LTE Cat-1
- 支持电信 LTE Cat-1
- 支持 AT 指令集
- 支持 SMS 功能
- 支持数据传输功能
- 支持 USB 通讯
- 支持 Windows、Linux、Android 平台

2.2. 基本参数

表 2 WH-GM5-mPCIe 关键参数表

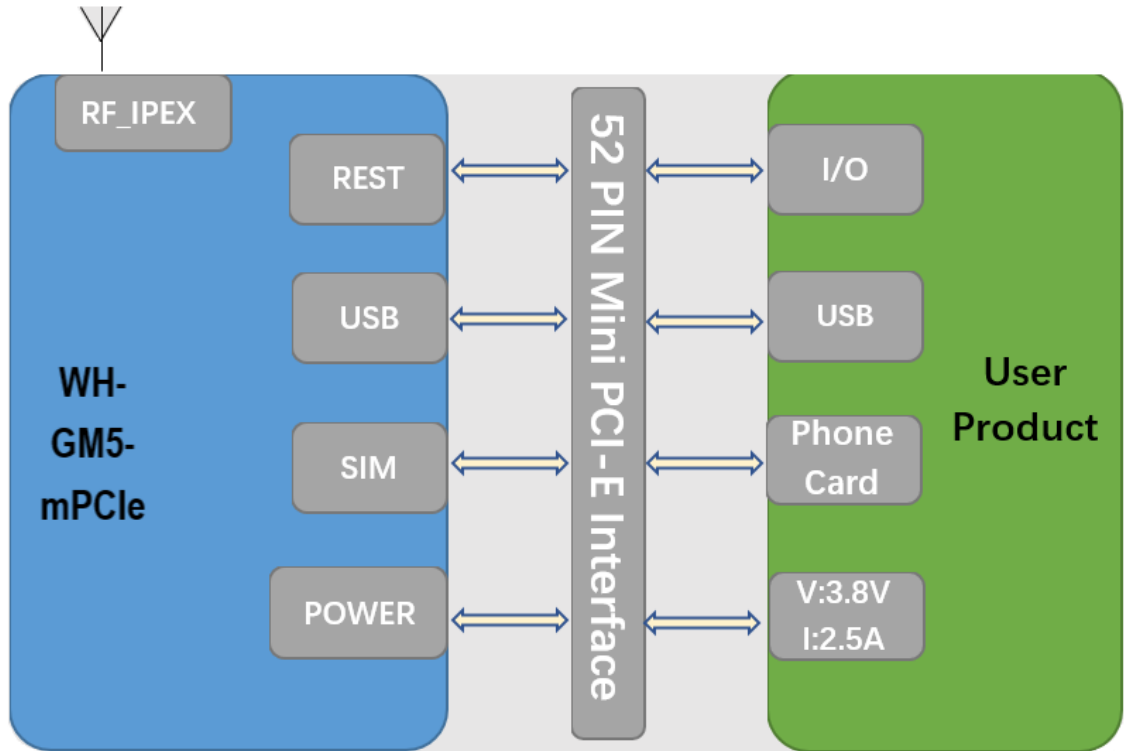
参数		描述
产品名称	WH-GM5-mPCIe	支持移动 2G/LTE Cat-1
		支持联通 2G/LTE Cat-1
		支持电信 LTE Cat-1
硬件接口	封装形式	Mini PCI-E 52PIN 模块
	电源	供电范围 3.3V~4.2V, 推荐值 3.8V
	状态指示脚	模块状态指示引脚
	SIM/USIM 卡	标准 6 针 SIM 卡接口, 3V/1.8V SIM 卡
	USB 协议	USB 2.0 High speed
	UART 接口	通信串口: UART0, 用于 AT 指令和数据传输。支持波特率 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800.
	RF	硬件带 ANT-MAIN 主天线.

外形尺寸	尺寸(毫米)	51mm×30mm×4.5mm
	重量(克)	约 11g
温度范围	工作温度	-35°C~ +75°C
	存储温度	-40°C~ +85°C
湿度范围	工作湿度	5%~95%
启动电流	3.8V	125mA
平均工作电流	3.8V	35mA
技术规范	TD-LTE	3GPP R9 CAT1 下行 7.5Mbps, 上行 1Mbps
	FDD-LTE	3GPP R9 CAT1 下行 10 Mbps, 上行 5 Mbps
	GSM	下行速率 384 kbps 上行速率 128 kbps
频段	TD-LTE	Band 38/39/40/41
	FDD-LTE	Band 1/3/5/8
	GSM	Band 3/8
功率等级	TD-LTE Band 38/39/40/41	+23dBm(Power class 3)
	FDD-LTE Band 1/3/8	+23dBm(Power class 3)
	GSM Band 8	+33dBm(Power class 4)
	GSM Band 3	+30dBm(Power class 1)
接收灵敏度	LTE-FDD B1(10MHz)	-97dBm
	LTE-FDD B3(10MHz)	-97dBm
	LTE-FDD B5(10MHz)	-99dBm
	LTE-FDD B8(10MHz)	-99dBm
	LTE-TDD B38(10MHz)	-98.5dBm
	LTE-TDD B39(10MHz)	-98.5dBm
	LTE-TDD B40(10MHz)	-98.5dBm
	LTE-TDD B41(10MHz)	-98.5dBm
频段收发电流	LTE-FDD B1(+23dBm)	622mA
	LTE-FDD B3(+23dBm)	646mA
	LTE-FDD B5(+23dBm)	543mA
	LTE-FDD B8(+23dBm)	609mA
	LTE-TDD B38(+23dBm)	320mA
	LTE-TDD B39(+23dBm)	251mA
	LTE-TDD B40(+23dBm)	378mA
	LTE-TDD B41(+23dBm)	381mA
软件功能	数据业务	支持PPPD/RNDIS/ECM拨号
	短信	支持 PDU/TEXT 短信
	TCP/IP协议	IPv4,IPv6,IPv4/IPv6双堆栈
	操作系统	支持 windows/linux/Android

2.3. 模块框图

目前模块开放的接口包括：电源输入、模块工作状态指示、USB2.0、SIM、射频天线。

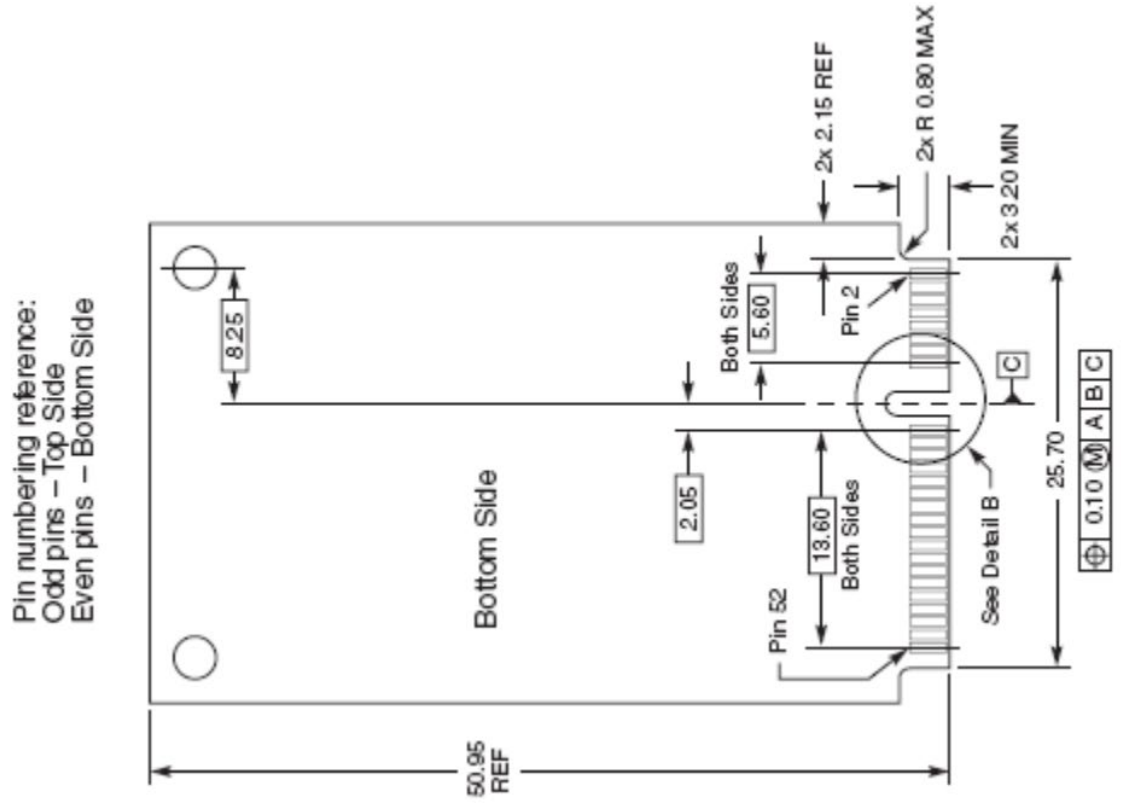
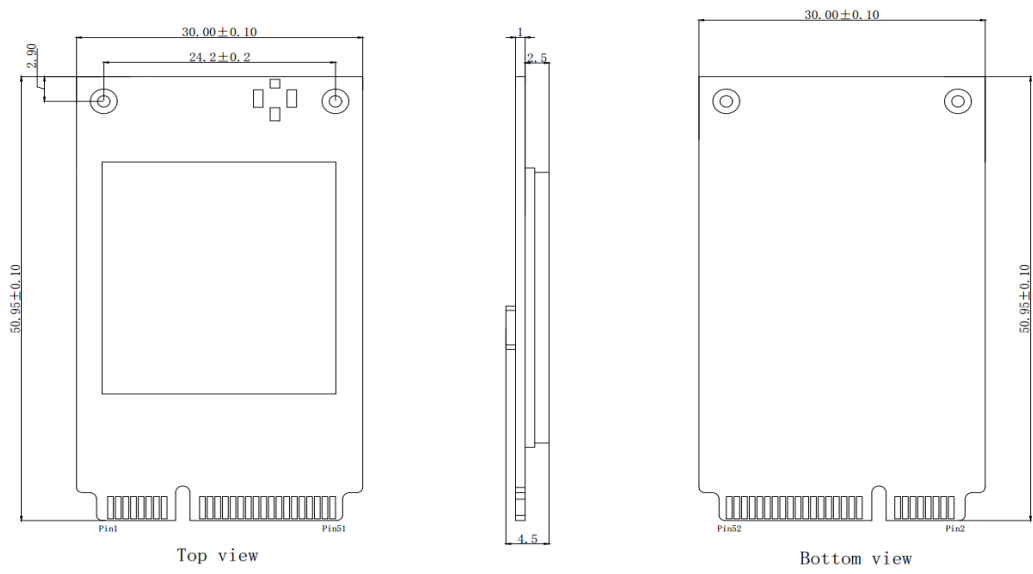
图 2 模块功能框图



2.4. 外形尺寸

2.4.1. 模块尺寸

注意：模块背部有器件，高度 1mm，模块整体高度尺寸公差±0.3mm.



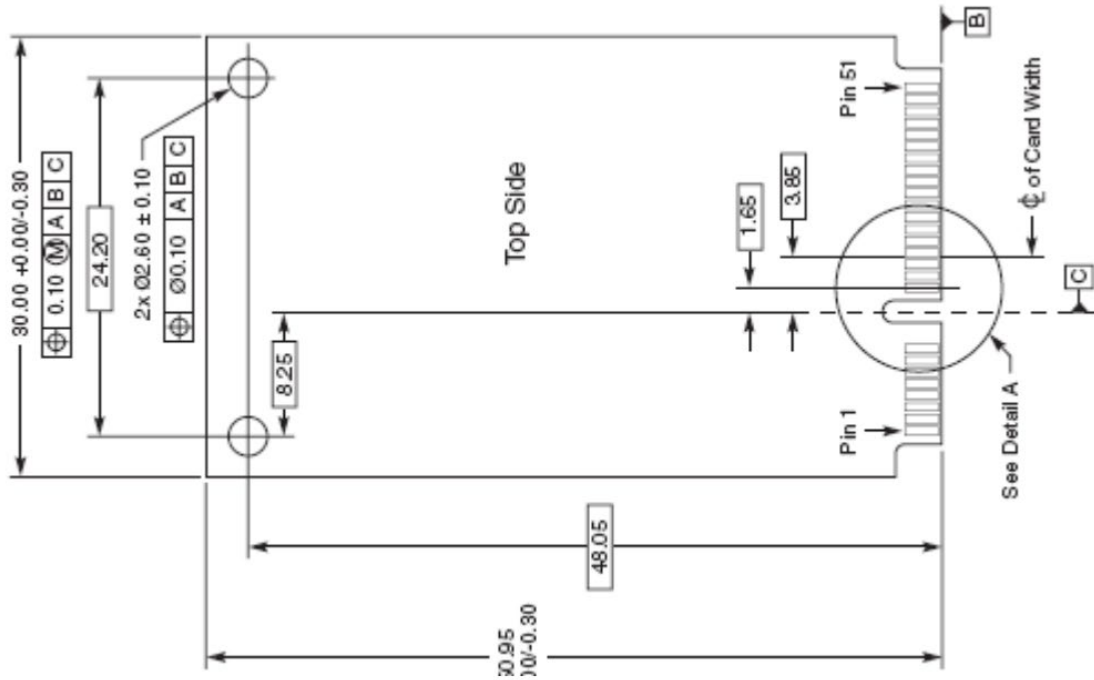


图 3 WH-GM5-mPCIe 封装尺寸图

2.4.2. Mini-PCIE

推荐 Mini PCI Express 连接器

表 3 Mini PCI Express 连接器推荐表

品牌	型号	作用
MOLEX	67910-5700	电气连接
MOLEX	48099-5701	支架

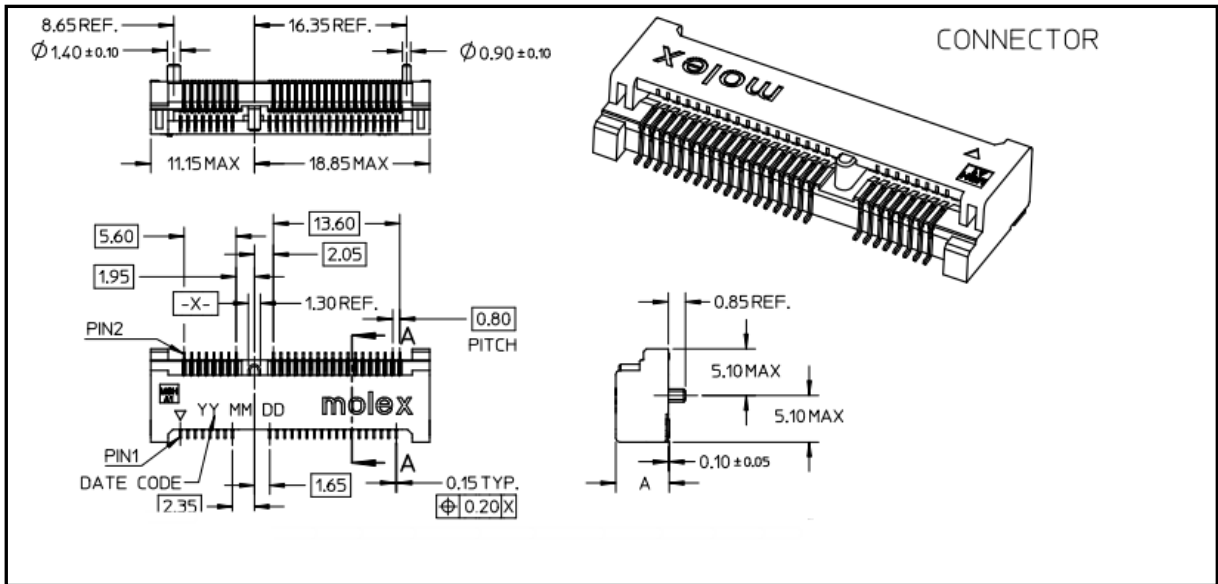


图 4 67910-5700 封装尺寸

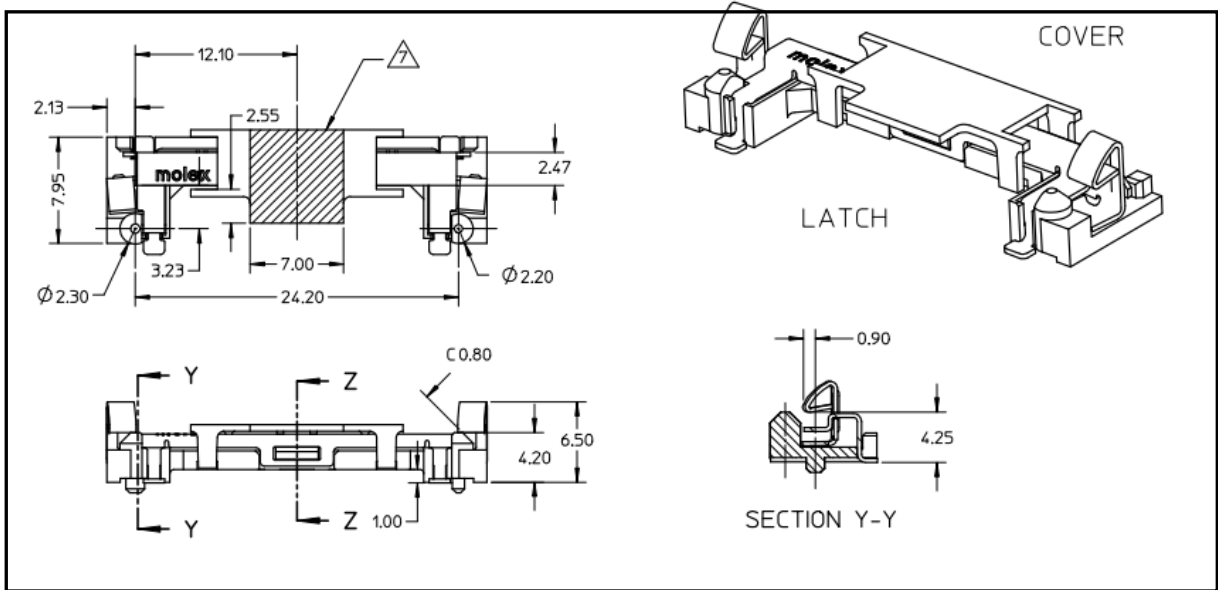
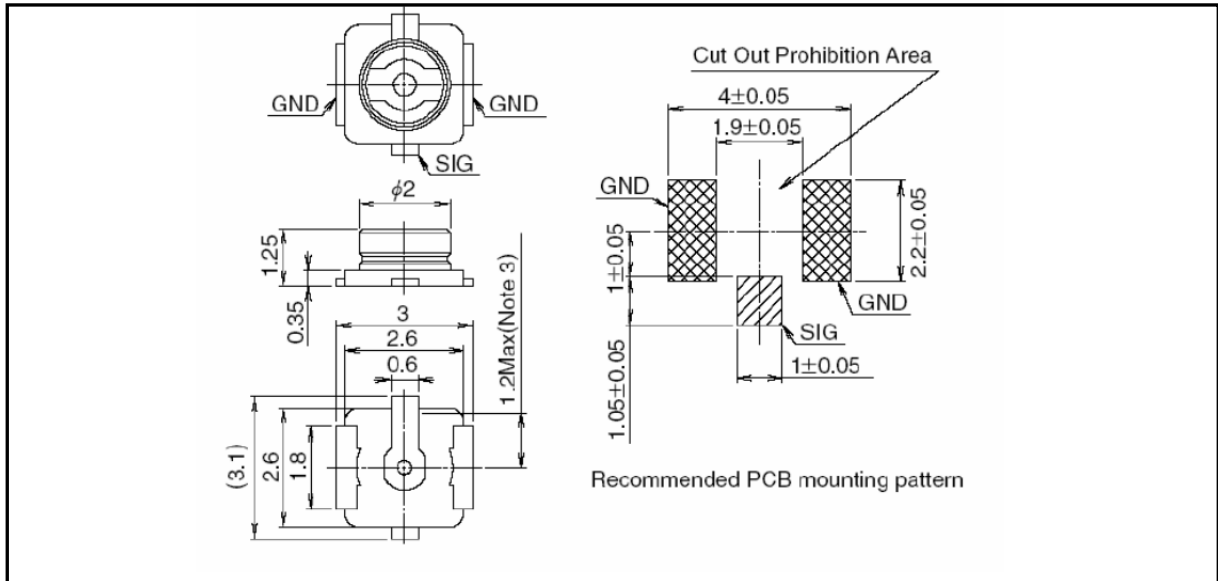


图 5 67910-5701 封装尺寸

2.4.3. IPEX

本产品的射频天线接口为主天线接口。

模块上 IPEX 尺寸图：


图 6 天线连接器封装尺寸图

2.5. 引脚定义

表 4 WH-GM5-mPCIe 引脚定义

PIN 脚定义				
管脚号	管脚号名称	描述	I/O	典型电压
1	NC	/	/	/
2	VBAT	Power supply for MODULE	P	3.8V
3	NC	/	/	/
4	GND	地	/	/
5	NC	/	/	/
6	NC	/	/	/
7	NC	/	/	/
8	VSIM_VDD	SIM/USIM 卡电源	P	1.8/3.0V
9	GND	地	/	/
10	SIM_DATA	SIM/USIM 卡数据信号	I/O	1.8/3.0V
11	V_PAD_1V8	1.8V 参考电平输出	P	1.8V
12	SIM_CLK	SIM/USIM 卡时钟信号	O	1.8/3.0V
13	NC	/	/	/
14	SIM_RST	SIM/USIM 卡复位信号	O	1.8/3.0V
15	GND	地	/	/
16	NC	/	/	/
17	NC	/	/	/
18	GND	地	/	/

19	NC	/	/	/
20	NC	/	/	/
21	GND	地	/	/
22	RESETN	模块复位脚,内部上拉,拉低 200ms 以上模块复位	I	1.8V
23	UART0_RXD	串口数据接收引脚	I	1.8V
24	VBAT	Power supply for MODULE	P	/
25	UART0_RTS	模块请求发送	O	1.8V
26	GND	地	/	/
27	GND	地	/	/
28	UART_CTS	模块发送清除	I	1.8V
29	GND	地	/	/
30	UART_DCD	模块载波检测	O	1.8V
31	UART0_TXD	串口数据发送引脚	O	1.8V
32	NC	/	/	/
33	RESETN	模块复位脚,内部上拉,拉低 200ms 以上模块复位	I	1.8V
34	GND	地	/	/
35	GND	地	/	/
36	USB_D-	USB 差分信号-	I/O	5V
37	GND	地	/	/
38	USB_D+	USB 差分信号+	I/O	5V
39	VBAT	Power supply for MODULE	P	3.8V
40	GND	地	/	/
41	VBAT	Power supply for MODULE	P	3.8V
42	WORK	模块工作状态引脚	O	/
43	GND	地	/	/
44	NC	/	/	/
45	NC	/	/	/
46	UART_DTR	DTE 准备就绪	I	/
47	NC	/	/	/
48	NC	/	/	/
49	NC	/	/	/
50	GND	地	/	/
51	NC	/	/	/
52	VBAT	Power supply for MODULE	P	3.8V

Note: P 表示电源类引脚

I 表示输入引脚

O 表示输出引脚

I/O 表示双向数据传输引脚

RF 表示无线射频

AI 表示模拟信号输入引脚

AO 表示模拟信号输出引脚

3. 硬件参考设计

3.1. 电源接口

电压供电范围 3.3V~4.2V，典型值 3.8V，峰值供电电流 2.5A，要保证靠近模块电源引脚并联数个百 μF 的储能电容以满足模块大电流脉冲需求，推荐组合 470 μF +220 μF 。同时预留一组 μF 级电容，做高频滤波使用，推荐 22 μF +0.1 μF +1nF+100pF。如果应用环境比较恶劣，经常受到 ESD 干扰或者对 EMC 要求比较高，建议串联磁珠和或者并联 TVS 管，以增加模块的稳定性

用户在设计产品时，首先保证外部用户在设计本产品外围电路能够提供充足的供电能力，并且供电范围要严格控制 在 3.3V~4.2V，供电电压波动 100mv，供电电压的跌落最小值保证大于 3.2V。并在 DC/DC 或者 LDO 后放置大电容，防止外部电源在脉冲电流时间段内出现电压跌落。系统板侧电源线应保证足够宽，走线长度尽量缩短并要与地面形成良好的回流。

表 5 电源参数

Symbol	Parameter	Min	Type	Max	Unit
VBAT	Power supply voltage	3.3	3.8	4.2	V
Io	Supply current capability	-	-	2500	mA

推荐电路如下所示。

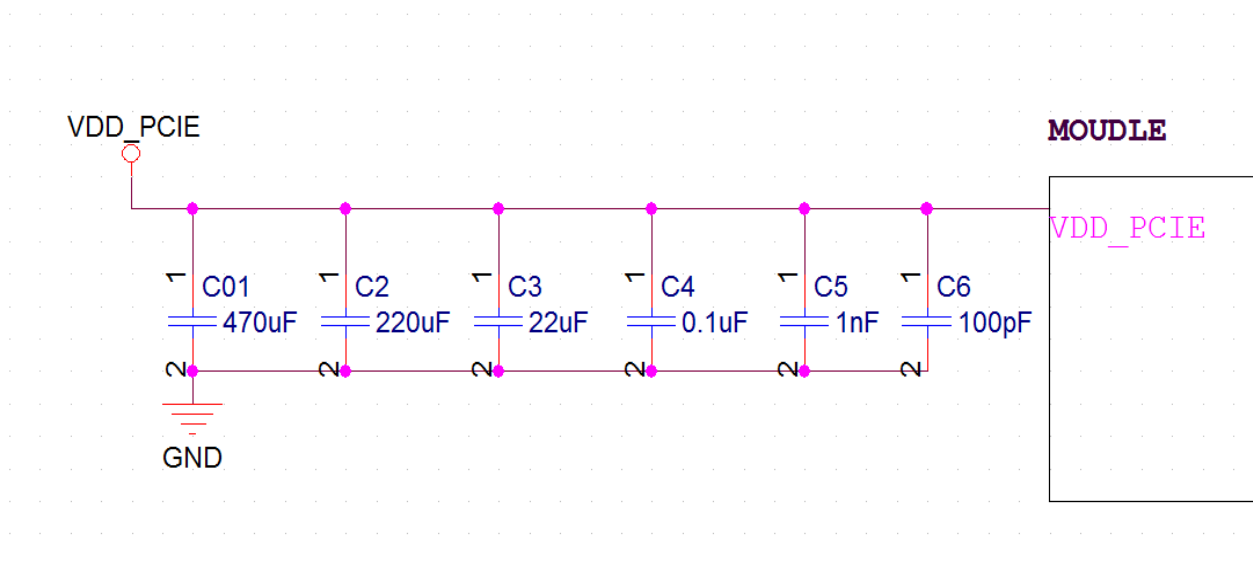


图 7 电源参考电路

3.2.USB 接口

模块提供 1 个标准 USB2.0 接口，支持 High speed (480Mbps) 和 Full speed (12Mbps) 两种电路，支持 suspend 和 resume，可以工作在 HOST 模式和 DEVICE 模式，该 USB 接口和驱动配合，可以在 PC 上映射多个串口。设计推荐电路如图 4-2 所示，USB 接口操作电源 USB_VCC 典型电压：5V（允许范围：4.75~5.25V）。根据应用产品的要求不同，一般需要考虑 ESD、EMI 的要求，设计建议：

- 1) 建议 USB 数据通路上串共模抑制滤波器或 0 欧电阻，以方便后续调试。
- 2) 作为操作接口或调试接口使用时，USB 信号线上必须考虑 ESD 接口防护，ESD 保护器件的结电容不大于 3PF。TVS 推荐 SEMTECH 的 RClamp0521P.TCT 或 INFINEO 的 ESD0P2RF-02LRHE6327，也可以按照参数同规格的其余器件。
- 3) USB_DP 和 USB_DM 严格按照差分形式走线，两根线的长度差尽量短，差分阻抗需控制在 90ohm。
- 4) USB_DP 和 USB_DM 需严格包地保护。

表 6 USB 引脚定义

PIN	Symbol	Description	Type voltage
36	USB_DM	USB-	5V
38	USB_DP	USB+	5V

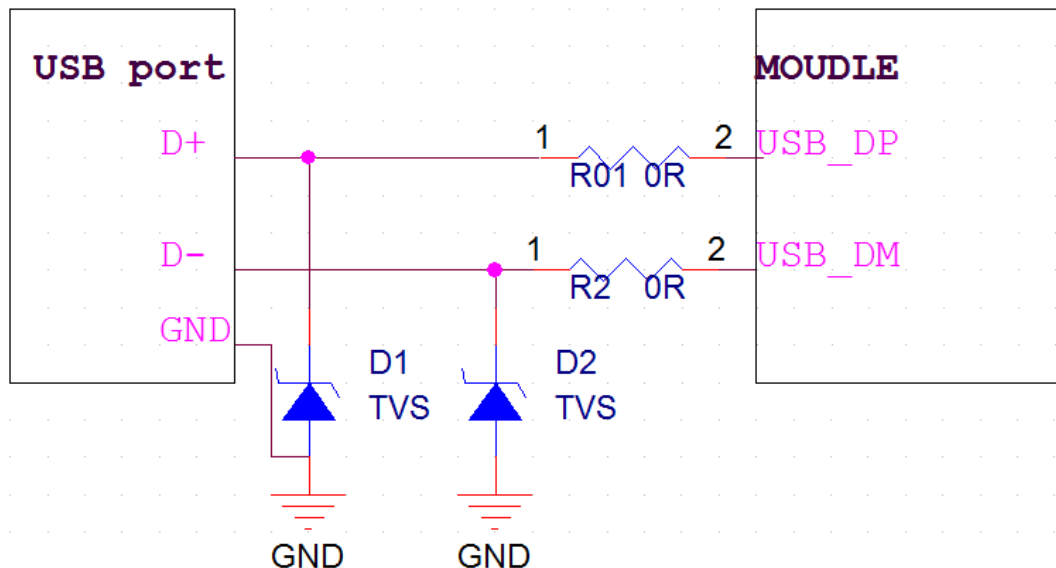


图 8 USB 参考电路

3.3. UART 接口

模块提供引出的 UART 接口分别位于 23,31 引脚，需要注意的是 UART 电平为 1.8V，不能直接与 3.3V 或其他电平的 MCU 相连，要使用电平匹配电路进行转换后才可以连接。DEVDD 为客户 MCU 的 I/O 标准电平。V_PAD_1V8 电源为模块 1.8V 电源输出。

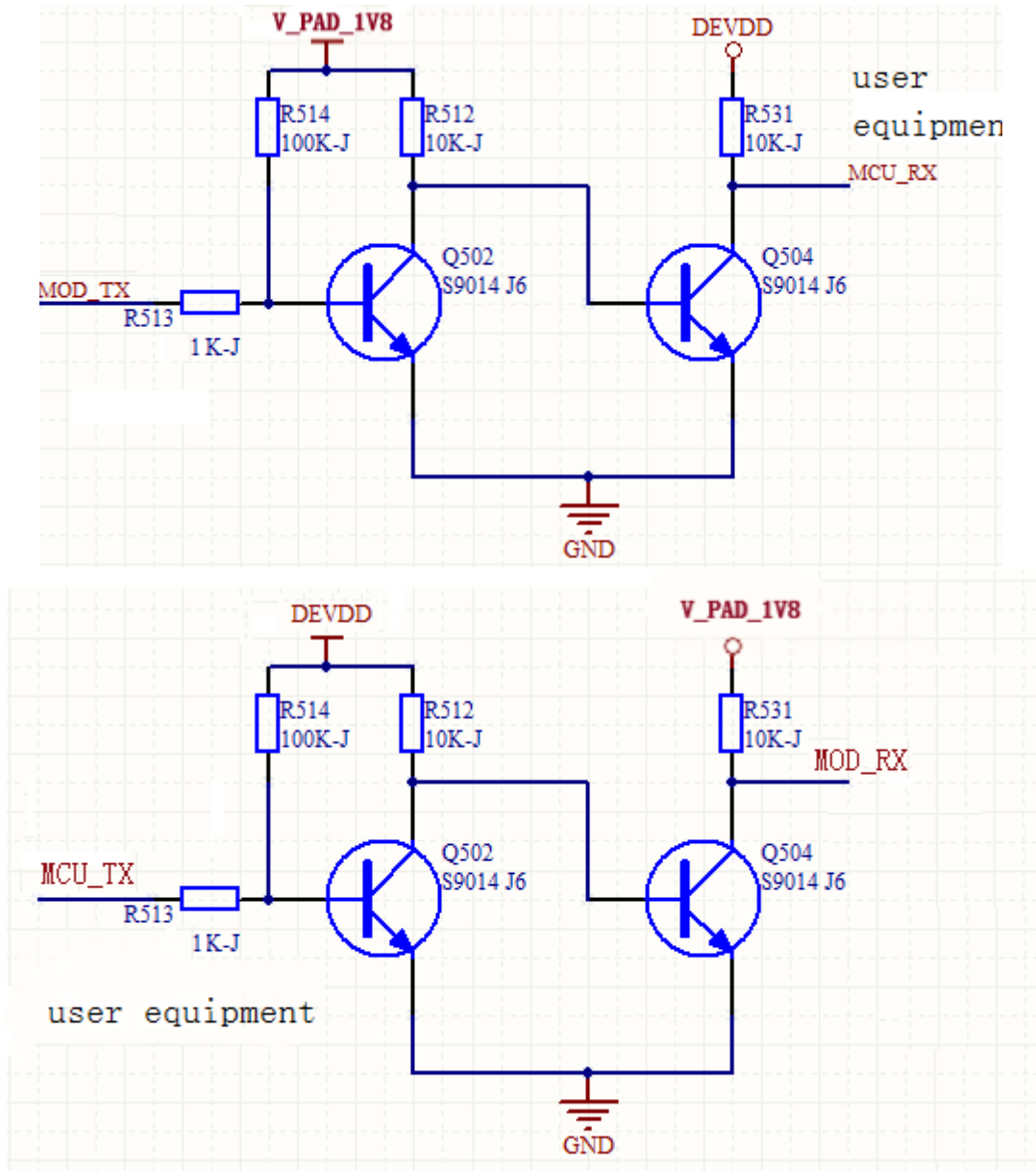


图 9 电平匹配参考电路

- 1、此电平转换电路支持波特率到 230400。若使用 460800 及以上波特率，则需要选用高速光耦器件或专用的电平转换芯片进行搭建。

3.4.SIM 卡接口

模块提供了符合 ISO 7816-3 标准的 SIM 卡接口，自动识别 3.0 V 和 1.8V SIM 卡。在标准模式下，向 USIM 卡提供 3.25MHz 的时钟信号；在低功耗模式下，向 USIM 卡提供 1.08MHz 的时钟信号；支持时钟关断模式；通过调整波特率参数，支持速度增强型 USIM 卡；支持 DMA 发送/接收；支持注销模式下的自动省电模式；在 RX 模式下，支持自动奇偶校验。

由于用户会经常进行插入或拔出 UIM 卡的操作，而人体带有静电，为了防止静电对 UIM 卡及芯片造成损坏，须要增加 TVS 管进行静电保护,作为 ESD 防静电措施。选用额定反向工作电压 $V_{rwm}=5\text{ V}$ ，结电容为 $C_j < 10\text{ pF}$ 以下的器件。防静电器件的接地须和模块系统地良好连接。

设计建议：

- 1) 建议对 SIM_DATA 用 VREG_SIM 电源 10K 上拉处理,保证 SIM_DATA 在三态时有一个稳定的高电平，以提高驱动能力,改善其波形的边沿特性。
- 2) 为了满足 3GPP TS 51.010-1 协议以及 EMC 认证要求，建议 SIM 卡座布置在靠近模块 SIM 卡接口的位置，避免因走线过长，导致波形严重变形，影响信号完整性。
- 3) SIM_CLK 和 SIM_DATA 信号的走线最好进行包地处理。
- 4) 在 VSIM_1V8_3V0 和 GND 之间并联一个 0.1uF 及 33pF 左右的电容，SIM_CLK，SIM_RST 与 GND 之间并联 33pF 左右的电容，滤除射频信号的干扰。
- 5) ESD 保护器件尽量靠近 SIM 卡槽放置

表 7 SIM# Pin Description

PIN	Symbol	Description	Type(V)
12	SIM_CLK	SIM clock	1.8/3.0
10	SIM_DATA	SIM Card data	1.8/3.0
14	SIM_RST	SIM Reset	1.8/3.0
8	SIM_VDD	Power output for SIM card	1.8/3.0

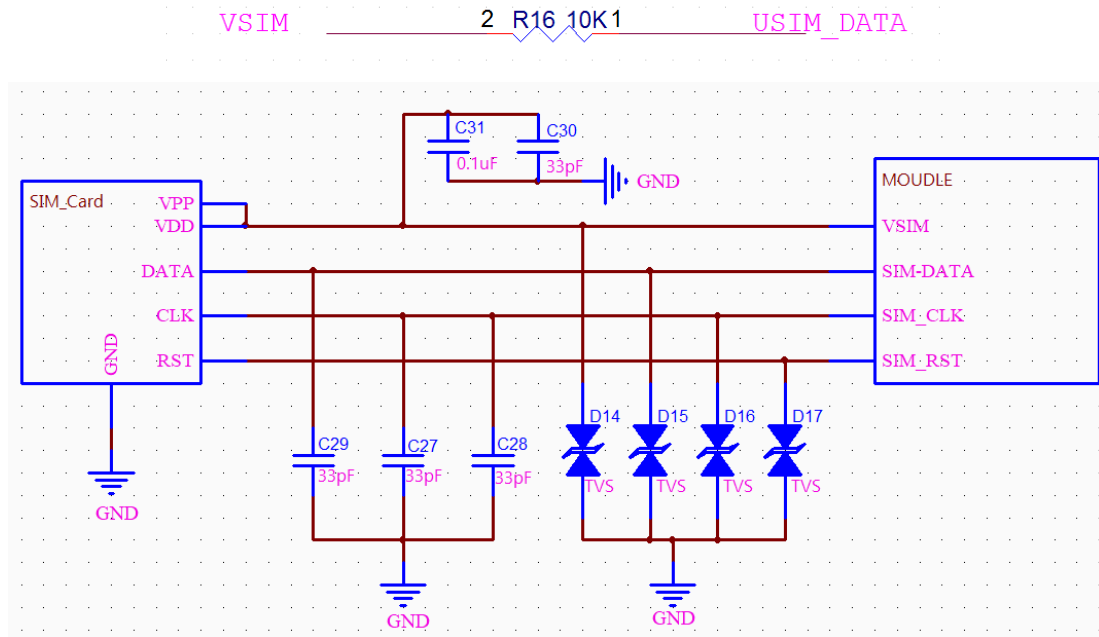


图 10 SIM 卡参考电路

4. 电气特性

4.1. 工作存储温度

工作存储温度如下图所示

表 8 Temperature Parameter

Parameter	Min	Max
Operating temperature	-35°C	+75°C
Storage temperature	-40°C	+85°C

4.2. 输入电源

表 9 Power Supply Characteristics

Parameter	Min	Typ	Max
Input Voltage (V)	3.3	3.8	4.2

Note: 任何接口的上电时间不要超过模块开机的时间, 否则, 有可能导致模块异常或者损坏。

4.3. 模块 IO 口电平

对于 SIM 卡电源引脚 VREG_SIM

1.8V U(S)IM 应用(Class C), VREG_SIM=1.8V;

3.0V U(S)IM 应用(Class B), VREG_SIM=2.85V

对于 RST、开关机、飞行模式等 IO 口:

表 10 I/O Voltage Specification

Symbol	Parameter	Min	Typ	Max	Unit
V _{IH}	High-level input voltage	1.17	1.8	2.1	V
V _{IL}	Low-level input voltage	-0.4	0	0.63	V
V _{OH}	High-level output voltage	1.35	1.8	1.8	V
V _{OL}	Low-level output voltage	0	0	0.45	V

5. 联系方式

公 司：上海稳恒电子科技有限公司

地 址：上海市闵行区秀文路 898 号西子国际五号楼 611 室

网 址：www.usr.cn

邮 箱：sales@mokuai.cn

电 话：021-52960996 或者 021-52960879

使命：做芯片到产品的桥梁

愿景：全球有影响力的模块公司

价值观：信任 专注 创新

产品观：稳定的基础上追求高性价比

6. 免责声明

本文档提供有关 WH-GM5-mPCIe 产品的信息，本文档未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除在其产品的销售条款和条件声明的责任之外，我公司概不承担任何其它责任。并且，我公司对本产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性，适销性或对任何专利权，版权或其它知识产权的侵权责任等均不作担保。本公司可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。

7. 更新历史

1. 2021-06-28 版本 V1.0.0 创立 冯&周